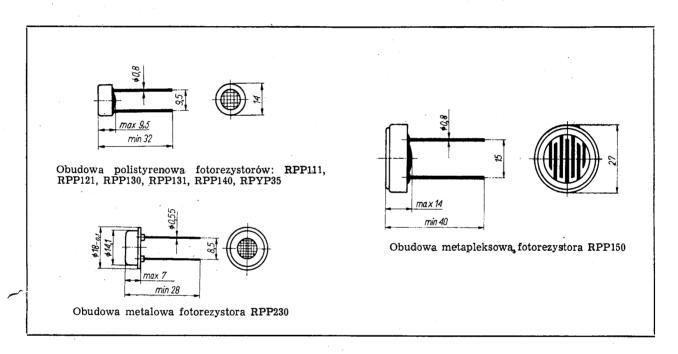
SWW 1156-619

Fotorezystory są detektorami promieniowania widzialnego. Są one przeznaczone do pracy w układach sygnalizacyjnych, kontrolnych, pomiarowych, rejestrujących, sterujących i alarmowych.

Warstwa światłoczuła jest zbudowana z siarczku kadmu. Dla typów RPP111, RPP121, RPP131, RPP140, RPYP35 elektrody można umieścić w podstawce lampowej typu heptal. W przypadku lutowania końcówek elektrod należy zapewnić odprowadzanie nadmiaru ciepła.

Zasilanie fotorezystorów napięciem stałym lub zmiennym. Przy zasilaniu napięciem zmiennym (f=50 Hz) rezystancja jasna fotorezystora wzrasta o 15% w porównaniu z rezystancją jasną przy zasilaniu napięciem stałym.



DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych;

 $t_{amb} = 22\pm5$ °C

		RPP 111\	RPP121	RPP130 RPP230	RPP131	RPP140	RPP150	RPYP35	
Napięcie maksymalne	U_{\max}	500	150	110	110	150	350	110	v
Moc dopuszczalna	P _{max}	0,2						0,2	w
Czas zaniku prądu fotoelektrycznego (E = 200 lx)	τ_z			0,25			0,3	0,25	S
Czas narastania prądu fotoelektrycznego (E = 200 lx)	τ_n	2 s							···
Współczynnik tempe- raturowy czułości	α	−2÷0°/₀/°C							
Rozkład widmowy czułości względnej	λ .	520÷700 nm							

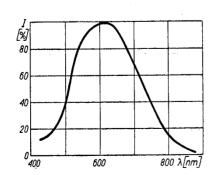
Parametry charakterystyczne: $t_{amb} = 22 \pm 5$ °C

Zakres temperatury

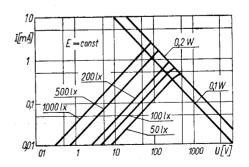
pracy t_{amb} 248...328 K (-25...55°C)

Maksimum rozkładu widmowego czułości λ_o

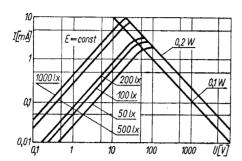
Parametry charakterystyczne	Гур	RPP111	RPP121	RPP130 RPP230	RPP131	RPP140	RPP150	RPYP35	Jed- nostka
Rezystancja jasna(E = = 1000 lx) przy U = 5 V U = 10 V U = 50 V	R_E	1 • 1045 • 104	1 · 1031 · 104	1·10²5·10²	4 · 1021,2 · 103	1.1035.104	40200	2550	Ω
Rezystancja ciemna przy U = 50 V U = 100 V	R_{O}	min. 1·10 ⁸	min. 1·10 ⁷ /	min. 1·107	min. 1·107	min. 1·107	min. 1·10¶	min. 5·104	Ω
Prad jasny $(E = 1000 lx)$ $przy U_E = 1 V$ $U_E = 5 V$ $U_E = 10 V$	IE	0,21	110	1050	4,1512,5	210	25125	2040	mA
Prąd ciemny $(E = 0)$ $przy U = 50 V$ $U = 100 V$	Ic	maks. 1	maks. 5		maks. 10	maks. 100	maks. 1000	μ Α	
Stała czasowa narastania prądu fotoele- ktrycznego (E = 200 lx)	τ _{ne}			maks. 0,6			maks. 6	maks. 0,6	s
Stała czasowa zaniku prądu fotoelektrycznego (E = 200 lx)	ο τ _{ze}			maks. 5·10-2	2		maks. 6·10 ⁻²	maks. 5·10 ⁻²	s
Czułość $(E = 1000 lx)$	s	1,15,5	28280	140700	60180	57280	55270	14302860	mA/V·ln
Powierzchnia czynna	A	0,18	0,035	0	,14	0,035	0,9	0,14	cm²



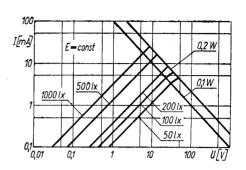
Charakterystyka widmowa (w jednostkach względnych) dla fotorezystorów RPP111, RPP121, RPP130, RPP230, RPP131, RPP140



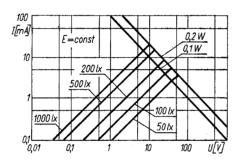
Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora RPP111



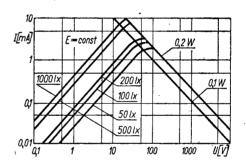
Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora RPP121



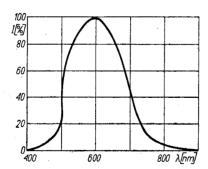
Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystorów RPP130, RPP230



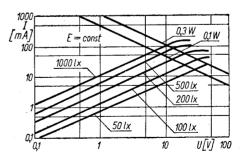
Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora RPP131



Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora ${\bf RPP140}$



Charakterystyka widmowa (w jednostkach względnych) dla fotorezystora RPP150



Charakterystyka prądowo-napięciowa fotorezystora ${
m RPP150}$